テラヘルツ波光源のための半導体レーザー制御技術の 可能性調査研究(I)

安達雅浩*1

松延 剛*2

野田純也*3

[要 旨]

電波と光波の中間的な性質を有するテラヘルツ波は、X線に代替するイメージング、薬物・爆発物 の非接触検知、バイオセンシング、高速無線通信などに有用性があり、今後さまざまなアプリケーシ ョンへの利用が進められていくことが予想される。しかし、テラヘルツ波に取り組むための環境整備 にはまだまだコストがかかり、技術普及の妨げになっていることから、本調査研究においては、昨年 度に引き続き、時間領域分光法に適用するための比較的安価な半導体レーザーの高速パルス発生手法 によるテラヘルツ波光源への適用を検討し、実用化への可能性を調査したので報告する。

1 はじめに

テラヘルツ波の計測には、テラヘルツ波をフー リエ変換することにより電磁波のスペクトルが得 られる時間領域分光法がよく用いられている。こ の方法は、テラヘルツ波の時間応答を計測するこ とから、振幅と位相の両方の情報が得られるとい うメリットがある。特にテラヘルツ波帯域の材料 評価には、複素屈折率・誘電率が得られることか ら、テラヘルツ波におけるエリプソメトリーや複 素誘電率評価に用いることが可能である。

時間領域分光法は、光源にフェムト秒パルスレ ーザーを用いて、光伝導アンテナと呼ばれるデバ イスを1対対向させ、テラヘルツ波の送受信する 構成により行う。入射するフェムト秒パルスレー ザーは2分割して、1方を送信用光伝導アンテナ に入射し、1方を受信用光伝導アンテナに入射す る構成で、1方を時間的に遅延させることで、テ ラヘルツ波の時間応答波形が得られる。光伝導ア ンテナの他にも非線形光学結晶を用いた電気光学

- *1 応用技術課 副主査
- *2 応用技術課 主任研究員
- *3 応用技術課 技師(現京都府営水道事務所主任)

サンプリング法があるが、光伝導アンテナは広帯 域なテラヘルツ波を送受信できることから、更な る高周波帯域まで網羅できることがわかっている。 また、光伝導アンテナは、半導体基板上に電極を パターニングするシンプルな構造で、作成も容易 であることから、テラヘルツ波技術に取りかかる には、最もアプローチがしやすいと考えられる。

本可能性調査研究においては、テラヘルツ波技 術に取り組もうとされるときに、簡易的・ローコ ストでの時間領域分光法を構築するために、高速 光パルスの小型化・低価格化に向けた試行を行っ た。

2 実験方法及び結果

2.1 光パルスの生成

半導体レーザー(LD: Laser Diode)のゲイン スイッチング手法により発生した高速光パルスは、 短波長側が早く、長波長側が遅く進むレッドシフ トチャープと呼ばれる状態で発振することから、 発生した光パルスをチャープ補償することで、本 来有する最も速い応答パルス(フーリエ限界パル ス)に近づけることが可能である。このチャープ 補償量は、連続波(CW)動作時からゲインスイ ッチング動作をしたときの光スペクトラムの広が りからフィードバックすることで見積もることが できる。ゲインスイッチング発生回路及び測定構 成を図1に示す。



図 1 ゲインスイッチング光パルスを観測す るための実験構成

半導体レーザーは CW 駆動時 20mW、中心波 長 1572nm の分布帰還型 (DFB) レーザーを用 いている。信号発生器 (SG) からの出力を高周波 アンプにて増幅できる構成を行い、2GHz 正弦波 の振幅強度を可変しながら、また LD ドライバに より温度 (25°C)・バイアス電流(6mA)を固定して ゲインスイッチングパルス光の発生の最適化を図 った。3dB アッテネータ (ATT) は、高周波信号 の伝送線路内での定在波抑制のために挿入した。 得られた時間波形図と光スペクトラム波形を図 2、 図 3 に示す。





図3からゲインスイッチング光パルスのスペク トル幅は0.33nm であり、変調前スペクトル幅の 0.156nmより、チャープ拡がりは、0.3nmとなり、 分散補償量は、-65ps/nmと見積もることかでき る。図1におけるゲインスイッチング光パルスの チャープ補償として、分散補償ファイバ (DCF) を挿入したときの実験構成を図4に、分散補償後 の波形を図5に示す。





図5 分散補償後の光パルス波形

図2と比較して図5はDCFの挿入損失により 透過減衰量が大きくなっていることから、光ピー ク強度を規格化することで、光パルス幅の比較を 行った結果を図6に示す。



図6 分散補償後のパルス時間波形

分散補償前後において、15ps 以上のゲインスイ ッチング光パルスのチャーピングが補正され、パ ルス幅圧縮が起こっていることが確認できる。こ の-65ps/nm における分散補償量の妥当性の検証 として、DCF の分散量を、それぞれ-55ps/nm、 -60ps/nm、-70ps/nm、-75ps/nm と変化させたと きに得られたパルス圧縮波形を図7に示す。



図7 分散補償量の最適化の検証

この結果から、-65ps/nm における分散補償量 で最もパルス圧縮効果が大きく、設計値の妥当性 が検証されている。なお、ゲインスイッチング光 パルスのチャープ補償により、フーリエ限界パル スでは半値全幅 (FWHM) 4.4ps まで高速化がで きることが見積もることができることから、光パ ルス幅はもっと狭くなっていることがうかがえる。

この計測に用いた光サンプリングオシロスコー プ(HP83480A)の帯域幅は 50GHz であること から、パルス幅の計測は20ps が限界であるため、 これ以上の狭いパルス幅を確認することができな い。フーリエ限界パルスに到達しているかどうか の確認には、一般的な光/電気変換で計測する計 測系から自己相関波形計測が可能なオートコリレ ーターが必要となる。

2.2 テラヘルツ波計測ステーションの構築

今回発生した光パルスにより、時間領域分光法 に基づく計測構成として、テラヘルツ波計測ステ ーションの構築を試みた。ゲインスイッチング光 パルスと DCF による高速光パルス発生から、1: 1分配器で分割し、受信アンテナ側は、光路長遅 延のためのステージを配置し、それぞれ光伝導ア ンテナ(送信・受信)に集光する光学系を全て光 ファイバで実現した。この構成を図 8、外観を図 9に示す。



図8 テラヘルツ波計測ステーション構成



図9 テラヘルツ波計測ステーション外観

今回テラヘルツ波計測ステーションに用いた光 伝導アンテナは、低温成長 GaAs 上にストリップ ラインを配置した TERA8-1 (ソーラボ社製)を 対向させ、送信側に+35Vのバイアス電圧を加え、 受信側の発生電流を計測する構成とした。送信側 の光伝導アンテナに光パルスが入射したとき、光 励起によるキャリアが生成され、アンテナに電流 が誘起される。一方で、受信側には分割された光 パルスによってほぼ同タイミングで光励起状態を 作り、送信されたテラヘルツ波が受信アンテナに 到達するとき、キャリアが生成され電流が流れる ことから、そのタイミングでのテラヘルツ波の時 間的な電場波形を取得することが可能となる。テ ラヘルツ波の発生パルスを取得するには、送受信 波の光路長に差を与えることでの電場波形全体を 網羅することができる。

しかしこのような基礎要件を基に、発生した光 パルスをテラヘルツ波計測ステーションに適用し たが、テラヘルツ波を検出することができなかっ た。この原因としては、光パルスの強度が低いこ とと、光伝導アンテナへの集光不足であると考え られる。また、微小電流変化を捉えるために、送 信アンテナのバイアス電圧を変調しながら、電流 値を計測可能なロックインアンプ検出を行うこと で、検出感度を向上することが可能である。

3 まとめ

今回テラヘルツ波時間領域分光のための高速光 パルスの発生法として、半導体レーザーのゲイン スイッチングパルス発生手法と DCF によるチャ ープ補償を行い、当センター所有の計測器での測 定限界である FWHM20ps を実現した。また、全 ての光学系を光ファイバによるテラヘルツ計測可 能な「テラヘルツ計測ステーション」を構築した。

発生した光パルスは、高速波形を測定可能なオ ートコリレーターにより、当センター所有の計測 限界以上の光パルス幅の確認が可能である。また、 「テラヘルツ計測ステーション」については、光 パルス強度の増幅、光伝導アンテナへの光パルス 入出射の位置決め精度の向上、ロックインアンプ による検出感度の向上により解決を図ることが可 能であると考えている。

(参考文献)

1) 伊藤 弘昌, 村田 茂, 横山 弘之, 稲葉 文 男, "高周波変調にもとづくAlGaAs半導体レ ーザーからの超短光パルス発生,"応用物理

50(1981)18

2) テラヘルツテクノロジーフォーラム編, "テラ

ヘルツ技術総覧,"(有)エヌジーティ(2007)

- 3)安達 雅浩、黒川 悟ほか、"近赤外光パルス を用いた分光分析に関する可能性について"、 京都府中小企業総合センター技報、31、15 (2003)
- 4) 斉藤冨士郎, "超高速光デバイス," 共立出版株式会社(1998)